

Germanium PNP Transistor


GC121

25V / 250mA

DATASHEET

OEM – RFT

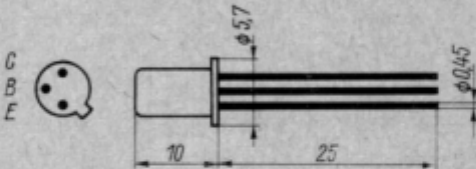
Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



RFT
electronic

GC 121, 2-GC 121


Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Treiberstufen in NF-Verstärkern, vorzugsweise als 2-GC 121 in Endstufen mittlerer Leistungen; gekennzeichnet durch geringen Stromverstärkungsabfall bis zum maximalen Kollektorstrom.



Masse ca. 0,8 g

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 25 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	= 20 V
$R_{BE} = 1\text{ k}\Omega$		
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 10 V
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 250 mA
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 50 mA
Sperrschichttemperatur	μ_L	= +80 °C
Umgebungstemperatur	θ_{eL}	= -25 °C bis +65 °C
Wärmewiderstand	R_{thja}	= 0,38 grd/mW
Wärmewiderstand	R_{thjc}	= 0,05 grd/mW



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

8.69
33

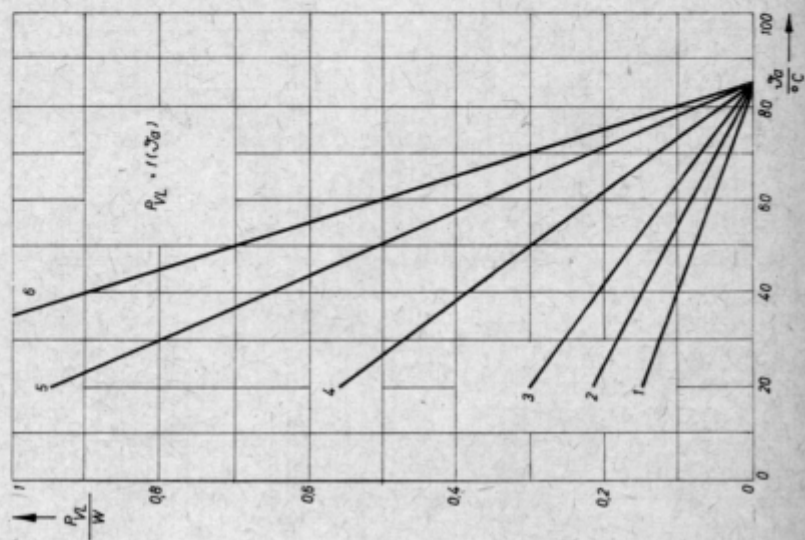
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15 \text{ V}$	$-I_{CBO}$		$9 \mu\text{A}$	$18 \mu\text{A}$	
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CER} = 20 \text{ V}$ $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$	$-I_{CER}$			$100 \mu\text{A}$	
Emitter-Basis-Reststrom $-U_{EB} = 10 \text{ V}$	$-I_{EBO}$		$12 \mu\text{A}$	$50 \mu\text{A}$	
Dynamische Kennwerte					
Grenzfrequenz $-U_{CE} = 2 \text{ V}$ $-I_C = 10 \text{ mA}$	f_{T210}	12 kHz			Stromverstärkungs- gruppe
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 0,5 \text{ V}$ $-I_C = 100 \text{ mA}$	h_{21E}	28 45 71 112		56 90 140 224	
h_{21E} -Verhältnis $h_{21E(100)}$ bei $-I_C = 100 \text{ mA}$ $h_{21E(250)}$ bei $-I_C = 250 \text{ mA}$	$\frac{h_{21E(100)}}{h_{21E(250)}}$		1,3		
Paarigkeitsbestimmungen $-U_{CE} = 6 \text{ V}; -I_C = 20 \text{ mA}$ $-U_{CE} = 0,5 \text{ V}; -I_C = 100 \text{ mA}$	$\frac{I_{B1}}{I_{B2}}$	0,833	1,2		
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 6 \text{ V}; -I_C = 3 \text{ mA}$	$-U_{BE}$		$0,18 \text{ V}$		
Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe D		Transistor GC 121 D			
Bestellbeispiel für ein Pärchen der Stromverstärkungsgruppe D		Transistorpaar 2-GC 121 D			





GC 116...GC 123

1. freitragend
2. mit Kühlstern $h = 9 \text{ mm}$, $d = 10 \text{ mm}$
3. mit Kühlfläche Al 2 stark vertikal montiert, unbearbeitet $A = 9 \text{ cm}^2$
4. Kühlfläche $A = 25 \text{ cm}^2$
5. Kühlfläche $A = 100 \text{ cm}^2$
6. mit angenähert idealer Kühlung



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
 Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

